

**17-я Всероссийская молодежная научная школа-семинар**  
**“АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ**  
**ФИЗИЧЕСКОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ”**  
**2-4 декабря 2014 г., г. Ульяновск**

---

---

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**

**УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!**

Приглашаем Вас принять участие в работе 17-й Всероссийской молодежной научной школы-семинара «Актуальные проблемы физической и функциональной электроники», которая состоится со 2 по 4 декабря 2014 г. в Ульяновском филиале Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 48/2).

**Организаторы школы-семинара:**

- Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН (Ульяновский филиал)
- Ульяновский государственный технический университет

**При поддержке:**

- Президиума РАН.
- Российского Союза научных и инженерных организаций (Ульяновское отделение)

**Председатель Программного комитета**

Гуляев Ю.В. – академик, ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, Москва, Россия

**Заместитель председателя Программного комитета**

Никитов С.А. – чл.-корр. РАН, ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, Москва, Россия

**Заместитель председателя Программного комитета**

Сергеев В.А. – д.т.н., УФ ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, Ульяновск, Россия

**Программный комитет:**

1. Браже Р. А. – УлГТУ, Ульяновск, Россия
2. Горлов М. И. – ВГТУ, Воронеж, Россия
3. Гурин Н. Т. – УлГУ, Ульяновск, Россия
4. Иванов О. В. – УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, Ульяновск, Россия
5. Лазарев Ю. Н. – СамНЦ РАН, Самара, Россия
6. Нефедов В. И. – МИРЭА, Москва, Россия
7. Самохвалов М. К. – УлГТУ, Ульяновск, Россия
8. Прокопенко Н. Н. – ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты Ростовской области, Россия
9. Пряников В. С. – ЧГУ им. И. Н. Ульянова, Чебоксары, Россия
10. Рогов В. Н. – УлГТУ, Ульяновск, Россия
11. Трефилов Н. А. – МИРЭА, Москва, Россия
12. Ташлинский А. Г. – УлГТУ, Ульяновск, Россия
13. Филимонов Ю. А. – СФ ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, Саратов, Россия
14. Черторийский А. А. – УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, Ульяновск, Россия
15. Шевяхов Н. С. – СарФТИ НИЯУ МИФИ, Саратов, Россия
16. Широков А. А. – УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, Ульяновск, Россия
17. Ярушкина Н. Г. – УлГТУ, Ульяновск, Россия

**Оргкомитет:**

Сергеев В. А. – председатель, Черторийский А. А. – заместитель председателя, Браже Р. А., Гавриков А. А., Иванов О. В., Лушников Е. А., Моисеев С. Г., Смирнов В. И., Фролов И. В., Урлапов О. В.

**Контакты:**

*Лушникова Елена Андреевна*, УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН,  
Ульяновск, ул. Гончарова, д. 48/2; Телефон/Факс: 8(8422) 44-02-13, E-mail: [ufire@mv.ru](mailto:ufire@mv.ru)  
*Фролов Илья Владимирович*, УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН,  
Ульяновск, ул. Гончарова, д. 48/2; Телефон/Факс: 8(8422) 44-25-35, E-mail: [ufire@mv.ru](mailto:ufire@mv.ru)

**Вся необходимая информация представлена на сайте конференции  
[ulireran.ru](http://ulireran.ru)**

Школа-семинар «Актуальные проблемы физической и функциональной электроники» проводится ежегодно, начиная с 1998 г., на базе совместного Учебно-научного центра УлГТУ и УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, созданного в рамках проекта ФЦП «Интеграция». С 2006 г. школа-семинар проводится в рамках целевой программы Президиума РАН «Поддержка молодых ученых», с 2014 года школа-семинар имеет статус Всероссийской.

**Участники школы-семинара:**

Молодые (возрастом до 35 лет включительно) ученые, преподаватели и специалисты вузов и научных организаций, аспиранты, студенты и школьники.

**Планируется работа следующих секций:**

1. Волоконная оптика и техника
2. Физика нанокompозитных материалов и низкоразмерных структур
3. Электроника и микроэлектроника СВЧ
4. Теплофизические процессы в электронных приборах
5. Электронные средства связи и телекоммуникаций
6. Электронные средства измерений и контроля
7. Математическое моделирование и проектирование в электронике
8. Физические исследования и разработки школьников

**Пленарные доклады**

Для расширения эрудиции и повышения квалификации молодых ученых и студентов – участников школы-семинара – предполагается чтение лекций обзорного характера известными учеными, работающими в области физической электроники, методов моделирования и исследования нанокompозитных материалов и структур, опто-, микро- и наноэлектроники, радиоэлектроники и волоконной оптики.

**Сборник материалов:** тезисы докладов участников школы-семинара будут опубликованы в виде сборника материалов с присвоением ISBN.

**Порядок оформления участия:**

Для участия в школе-семинаре необходимо до **1 августа 2014 г.** прислать на адрес электронной почты [ufireschool@gmail.com](mailto:ufireschool@gmail.com) заявку (*Приложение 1*) и тезисы доклада (*Приложение 2*).

**ЗАЯВКА**  
на участие в 17-й научной школе-семинаре  
«Актуальные проблемы физической и функциональной электроники»

Фамилия Имя Отчество  
Дата рождения  
Место работы (учебы)  
Адрес учреждения/учебного заведения  
Занимаемая должность/место учебы  
Ученая степень, ученое звание  
Название доклада  
Ф.И.О., должность научного руководителя  
Телефон/факс E-mail

**Требования к оформлению тезисов**

Тезисы докладов предоставляются в электронном виде. Объем тезисов – до 2 м. п. стр.

1-я строка – тема доклада, шрифт Arial 15 пт., прописной полужирный

2-я строка – пустая

3-я строка – Ф.И.О. авторов, шрифт Arial 13 пт., строчный полужирный,

4-я строка – название организации, шрифт Arial 12 пт., строчный курсив.

Основной текст отделяется от заголовка пустой строкой. Текст должен быть подготовлен в Word версии не ниже 6.0, (**формат .rtf**)! шрифт Arial 15 пт., через 1 интервал, все поля 25 мм., отступ абзаца 0,7 см. Подрисуночные подписи - шрифт Arial 12 пт.

Список библиографических ссылок отделяется от текста пустой строкой, шрифт Arial 12 пт., заголовок «Список источников» не печатается.

Образец оформления тезисов доклада приведен в *Приложении 3*.

**Тексты тезисов, оформленные с отступлениями от требований, приниматься не будут!**

## **УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

**Круглов С. С., Дулов О. А.**

*Ульяновский государственный технический университет*

Значения внутренних емкостей транзисторов являются важными параметрами транзисторов, так как определяют частотные характеристики.....

используются в ОАО «НПП «Завод «Искра» при производстве транзисторов 2П301, 2П302, 2П305.

1. Аронов В.Л. Испытание и исследование полупроводниковых приборов. М.: Высшая школа, 1975.
2. ГОСТ 20398.5-74. Транзисторы полевые. Метод измерения входной, проходной и выходной емкостей.